**ДП "КВАЗАР-ИС"**

k_e_087c

14.06.2002

Этикетка изделия**KP1834BA87**Шинный формирователь
восьмиразрядный с инверсией**Аналог: 82C87****Технические условия: БКО.348.983-01 ТУ**

Микросхема KP1834BA87 представляет собой однокристальный двунаправленный 8-разрядный шинный формирователь инвертирующий.

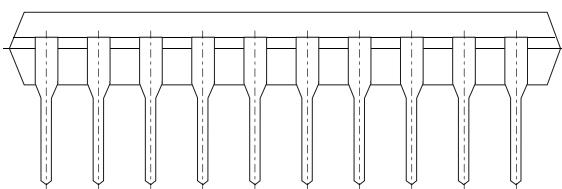
Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе по КМОП технологии, предназначена для применения в составе 8-16-разрядных микропроцессорных системах с малой потребляемой мощностью, а также в других устройствах, где требуется двунаправленная передача информации.

Схема расположения выводов:

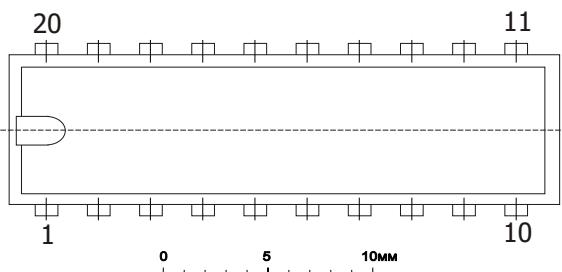
KP1834BA87 - корпус DIP20 (k_d_0d20)

А) Вид сбоку Б) Вид сверху

А)



Б)

**Таблица назначения выводов**

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
1	Вход/Выход A0	11	Вход направление передачи T
2	Вход/Выход A1	12	Вход/Выход B7
3	Вход/Выход A2	13	Вход/Выход B6
4	Вход/Выход A3	14	Вход/Выход B5
5	Вход/Выход A4	15	Вход/Выход B4
6	Вход/Выход A5	16	Вход/Выход B3
7	Вход/Выход A6	17	Вход/Выход B2
8	Вход/Выход A7	18	Вход/Выход B1
9	Вход разрешения выхода OE	19	Вход/Выход B0
10	Общий	20	Напряжение питания Ucc



ДП "КВАЗАР-ИС"

КР1834ВА87

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25⁰С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		Не менее	Не более
Выходное напряжение низкого уровня, В U _{cc} = 4,5 В по выходам стороны А I _{OL} = 16 мА по выходам стороны В I _{OL} = 32 мА	U _{OL}	-	0,4
Выходное напряжение высокого уровня, В U _{cc} = 4,5 В по выходам стороны А I _{OL} = -1 мА по выходам стороны В I _{OL} = -5 мА	U _{OH}	3,7	-
Входной ток низкого уровня, мкА U _{cc} = 5,5 В U _{IL} = 0,45 В	I _{IL}	-	45
Входной ток высокого уровня, мкА U _{cc} = 5,5 В U _{IH} = 5,5 В	I _{IH}	-	45
Ток потребления, мА U _{cc} = 5,5 В	I _{cc}	-	0,1
Время задержки распространения при включении или выключении, нс, U _{cc} = 5,0 В сторона А: U ₁ = 2,28 В C _L = 100 пФ R _L = 114 Ом сторона В: U ₁ = 2,14 В C _L = 200 пФ R _L = 82 Ом	t _p HL/LH	-	30
Время задержки распространения при включении третьего состояния высокого или низкого уровня, нс U _{cc} = 5,0 В U ₁ = 1,5 В сторона А: C _L = 50 пФ R _L = 68 Ом сторона В: C _L = 50 пФ R _L = 53 Ом	t _p HZ/LZ	-	18
Время задержки распространения при включении из третьего состояния в состояние высокого или низкого уровня, нс U _{cc} = 5,0 В U ₁ = 1,5 В сторона А: C _L = 100 пФ R _L = 900 Ом (zH), R _L = 68 Ом (zL) сторона В: C _L = 200 пФ R _L = 180 Ом (zH), R _L = 53 Ом (zL)	t _p ZH/ZL	-	30